

レーザー学会産業賞「優秀賞」受賞



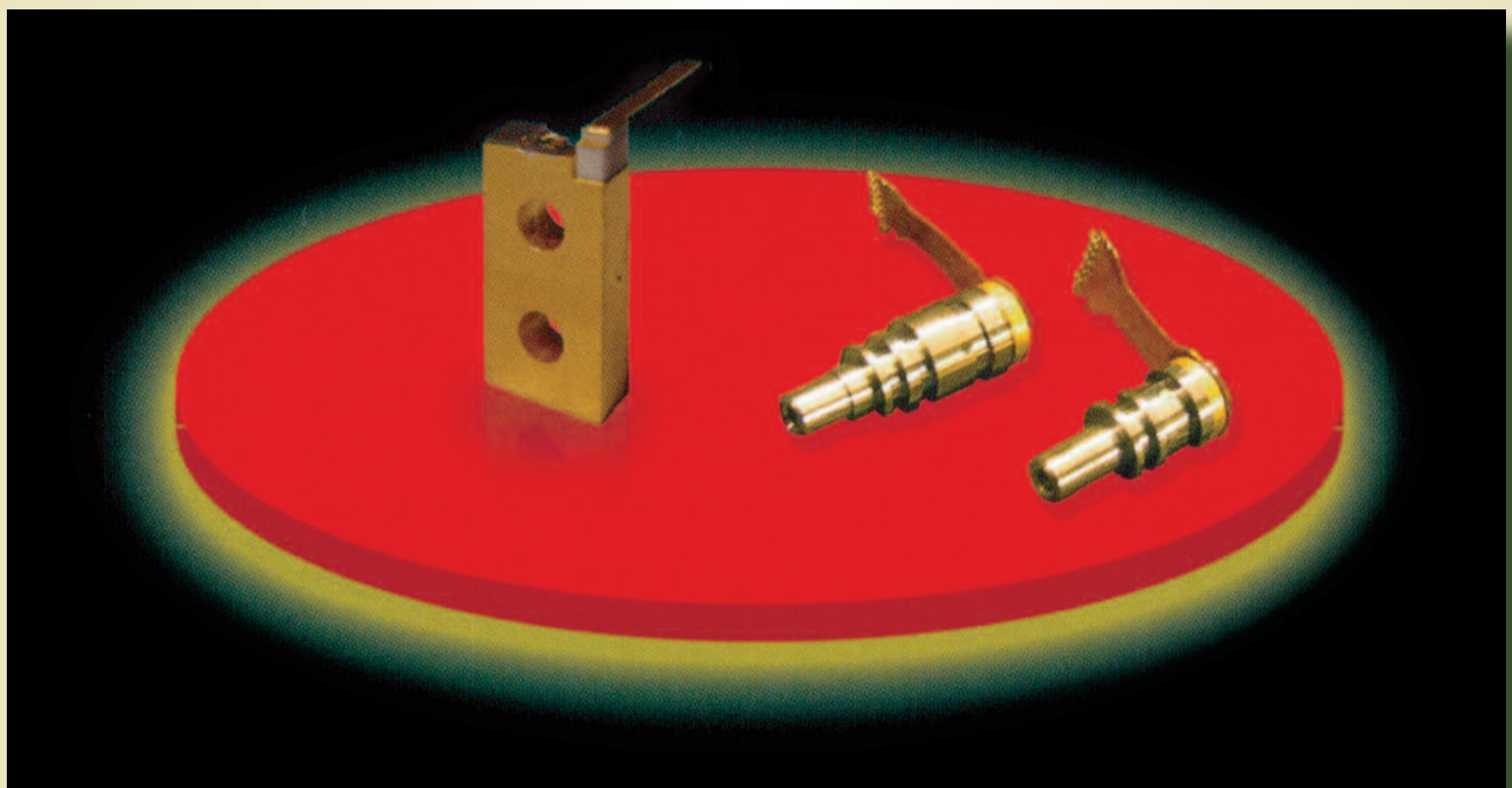
# 1.3 $\mu$ m帯 非冷却10Gb/s 直接変調レーザー／モジュール

HITACHI  
Inspire the Next

(株)日立製作所

opnext

日本オプネクスト(株)



高利得活性層、及び信頼性と生産性に優れたリッジ型レーザ構造を適用することにより85℃までの高速特性を達成しました。標準の10Gb/s規格より高速なFEC(forward error correction)付きの10.7Gb/s動作においても優れた動作特性を示します。

## 特性（10.7Gb/s, XMD-TOSAモジュール搭載）

- 光高範囲温度動作：-5～85℃
- 高マスクマージン：10%以上
- 高消光比： $\geq 7$ dB
- 高副モード抑圧比 (>30dB)

## 用途

- 10Gb/s光伝送送信光源（SONET（10.7Gb/s, OC-192）, 10G-Ether）  
伝送距離：10km